

## 产品简介

ZDN8321 是一款基于 GaN 工艺、320W 输出功率的预匹配宽带功率晶体管，该器件工作频率范围 DC~2GHz，具有高效率、高功率、热稳定性及负载耐受性的特点。ZDN8321 采用 780P2GB 封装，具有很好的可靠性和经济性。

## 典型应用场景

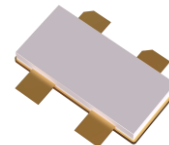
- 通信
- 电磁兼容 EMC
- 无线电定位
- 遥测遥控


## 极限最大额定值

参数	数值
存储温度	-65°C~+150°C
漏源电压 (V <sub>DS</sub> )	0~55V
漏源击穿电压 (V <sub>DSS</sub> )	150V
栅源电压 (V <sub>GS</sub> )	-10V~2V
最大正向栅极电流 (I <sub>GMAX</sub> )	78.4mA

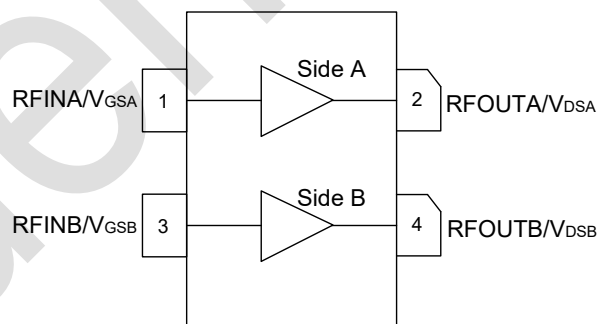
## 产品特点

- 典型工作电压 32V，静态电流 600mA
- 典型功率增益：11dB @ 1500MHz
- 饱和输出功率：56dBm @ 1500MHz
- 最大漏极效率：>70%
- GaN HEMT 工艺制程
- 绿色无铅 780P2GB 封装



 本产品符合所有相关法规且不含卤素。

## 管脚示意图 (Top View)



PIN #	管脚名称	说明
1	RFINA/VGSA	射频输入 A/栅源电压 A
2	RFOUTA/VDSA	射频输出 A/漏源电压 A
3	RFINB/VGSB	射频输入 B/栅源电压 B
4	RFOUTB/VDSB	射频输出 B/漏源电压 B



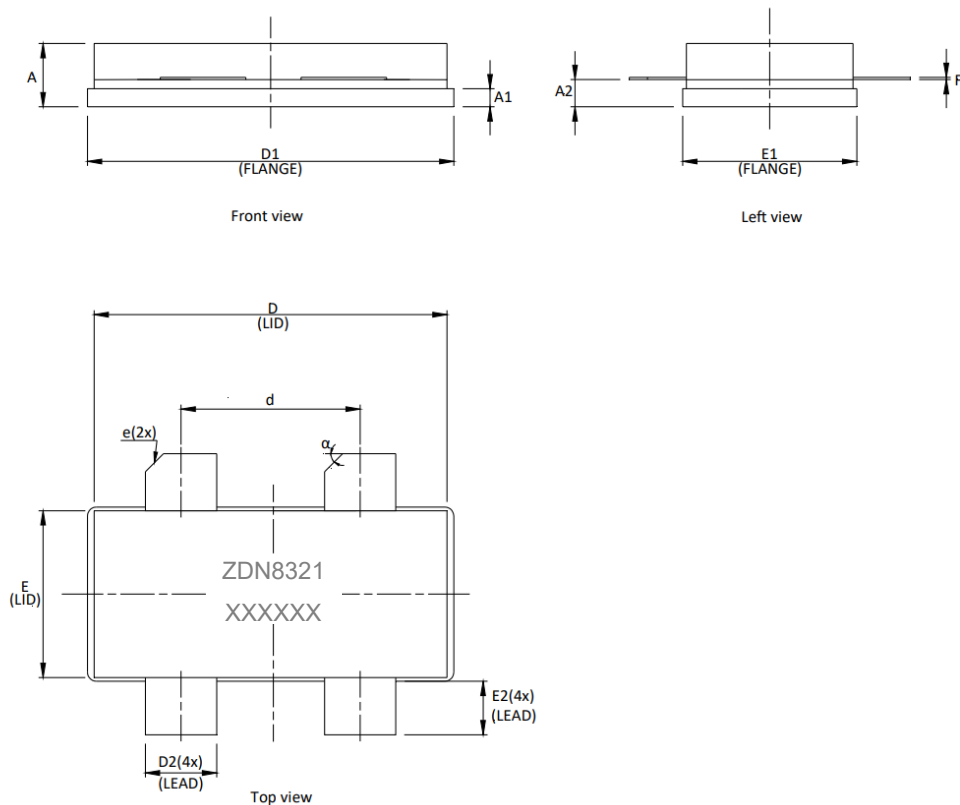
## 电气参数

### 射频特性

测试条件:  $V_{DS}=32V$ ,  $I_{DQ}=600mA$ , CW 脉冲, 脉冲宽度为 100us, 10% 占空比。

频率 (MHz)	功率增益 $G_p$ (dB)	输出功率 $P_{sat}$ (dBm)	漏极效率 $\eta_D$ (%)
1100	11	55	62
1200	12	55	58
1300	12	56	61
1400	11	56	61
1500	11	56	60
1600	12	56	64
1700	10	56	70

封装尺寸示意图



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	3.40	3.65	3.90
A1	0.89	1.02	1.14
A2	1.45	1.58	1.70
D	19.61	19.82	20.02
D1	20.45	20.58	20.70
D2	3.87	4.00	4.13
d	9.77	9.90	10.03
E	9.27	9.40	9.53
E1	9.65	9.78	9.91
E2	2.50	3.00	3.50
e	TYP1.02		
F	0.08	0.12	0.15
$\alpha$	45°REF		

订单信息

型号	丝印	封装	最小包装
ZDN8321	ZDN8321	780P2GB	3,000